

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院關鍵材料學位學程 論文發表認定原則

112 年 2 月 15 日 111 學年度第 4 次學程會議通過

112 年 4 月 10 日 111 學年度第 6 次院務會議備查

一、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院關鍵材料學位學程（以下簡稱本學程），為辦理本學程博士生發表國際學術論文及發明專利之認定，依國立成功大學智慧半導體及永續製造學院關鍵材料博士學位學程修業辦法第六條第二項規定，訂定本原則。

二、本學程所稱國際學術論文認定標準如下：

(一)須為 SCIE 相關領域、影響係數(Impact factor)前(含)50%之期刊。排名及影響係數之認定，以論文投稿日後之任一年度所公布之 ISI 資料庫排名及影響係數為準，且提出申請時該論文應已發表。

(二)除指導教授、共同指導教授外，研究生應為論文第一作者，隸屬單位(affiliation)應僅列 Program on Key Materials, Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing, National Cheng Kung University。

但論文發表前，博士生有下列各目情形之一，可增(共)列隸屬單位：

- 1.與本校或本學院簽有正式合作備忘錄或意向書等機構合作，並有支領對方經費者；
- 2.與簽准共同指導教授之單位合作，並有支領對方經費者；
- 3.以在職生身分入學者，可共列其工作單位；
- 4.有支領校內各級單位或中心之經費者。

(三)論文通訊作者應為指導教授，且列本校為服務單位(affiliation)之一。

(四)論文發表在無明顯標示通訊作者之期刊時，應檢附指導教授為通訊作者之證明。

論文第一作者有數人貢獻相同時，貢獻權重均分之，可累計發表論文數加總貢獻權重。

三、本學程所稱發明專利認定標準如下：

(一)以修業期間通過美國、日本或歐洲等國之發明專利為原則。

(二)專利之發明人應包含博士生及其指導教授。

(三)專利之所有權人應包含本校或本學院。

(四)專利題目應與其博士學位論文有關。

(五)專利申請日期應為博士生就讀本校期間。

四、本原則經本學程會議通過後實施，送院務會議備查，修正時亦同。